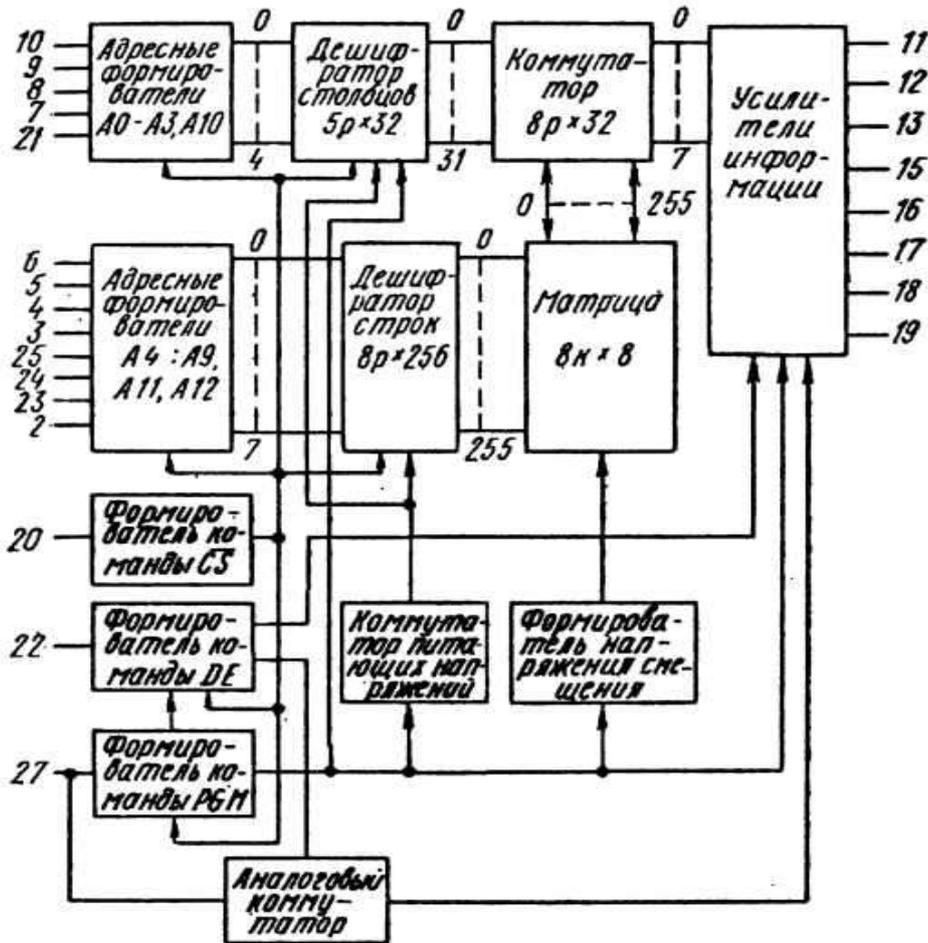
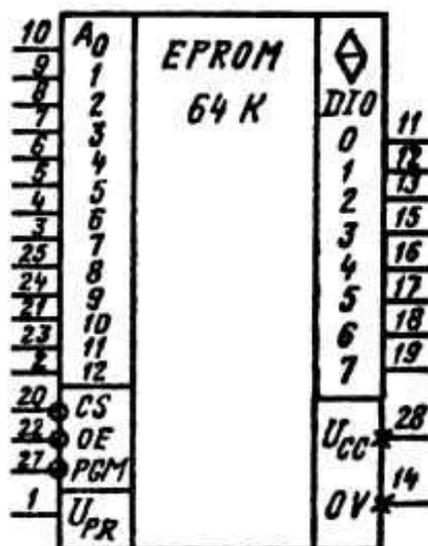


# К573РФ6А, К573РФ6Б

Микросхемы представляют собой электрическое программируемое ПЗУ емкостью 64 кбит (8кx8) с ультрафиолетовым стиранием информации, обеспечивающее длительное хранение информации независимо от режимов работы и возможность изменения записанной информации в процессе селективного программирования. Содержат 135210 интегральных элементов. Корпус типа 2121.28-6, масса не более 5,7 г.



Структурная схема К573РФ6



Условное графическое обозначение К573РФ6

Назначение выводов: 1 - напряжение программирования  $U_{PR}$ ; 2 - адрес A12; 3 - адрес A7; 4 - адрес A6; 5 - адрес A5; 6 - адрес A4; 7 - адрес A3; 8 - адрес A2; 9 - адрес A1; 10 - адрес A0; 11 - выход DIO0; 12 - выход DIO1; 13 - выход DIO2; 14 - общий; 15 - выход DIO3; 16 - выход DIO4; 17 - выход DIO5; 18 - DIO6; 19 - выход DIO7; 20 - вход  $\overline{CS}$ ; 21 - адрес A10; 22 - включение выхода  $\overline{OE}$ ; 23 - адрес A11; 24 - адрес A9; 25 - адрес A8; 26 - свободный; 27 - программирование  $\overline{PGM}$ ; 28 - напряжение питания.

### Электрические параметры

- Номинальное напряжение питания ..... 5 В  $\pm$  5%
- Выходное напряжение высокого уровня  
(при  $U_n = 4,75$  В,  $U_{пр} = 4,75$  В,  $U_{вх}^1 = 2,2$  В,  $U_{вх}^0 = 0,6$  В):
- в режиме "считывание" .....  $\geq 2,4$  В
  - при программировании .....  $\geq 2$  В
- Выходное напряжение низкого уровня:
- в режиме "считывание" .....  $\leq 0,4$  В
  - при программировании .....  $\leq 1$  В
- Ток потребления (при  $U_n = 5,25$  В):
- в режиме "считывания" .....  $\leq 100$  мА
  - при программировании .....  $\leq 150$  мА
- Ток потребления в режиме хранения по выводу 1:
- в режиме "считывания" .....  $\leq 4$  мА
  - при программировании .....  $\leq 30$  мА
  - в режиме "невыбор ИС" .....  $\leq 15$  мА
- Ток потребления в режиме "невыбор ИС" .....  $\leq 40$  мА

- Выходной ток низкого уровня .....  $\leq 1,6$  мА  
 Выходной ток высокого уровня .....  $\leq |-100|$  мкА  
 Ток утечки на входах в режиме "считывание" .....  $\leq 10$  мкА  
 Ток утечки на входах в режиме "невыбор ИС" .....  $\leq 30$  мкА  
 Ток утечки на выходах в режиме работы "невыбор ИС" .....  $\leq 30$  мкА  
 Потребляемая мощность:  
 - в режиме обращения .....  $\leq 870$  мВт  
 - в режиме хранения .....  $\leq 265$  мВт  
 Время установления высокого импеданса на выходе .....  $\leq 150$  нс  
 Время нарастания фронта (спада) .....  $\leq 100$  нс  
 Время выборки адреса в режиме "считывание"  
 (при  $U_n = 4,75$  В,  $U_{пр} = 4,75$  В,  $U^1_{вх} = 2,4$  В,  $U^0_{вх} = 0,4$  В):  
 - К573РФ6А .....  $\leq 280$  нс  
 - К573РФ6Б .....  $\leq 400$  нс  
 Время выборки по выводу 20:  
 - К573РФ6А .....  $\leq 300$  нс  
 - К573РФ6Б .....  $\leq 450$  нс  
 Время выборки по выводу 22 .....  $\leq 150$  нс  
 Время хранения информации выключенном состоянии .....  $\geq 5$  лет  
 Время хранения информации во включенном состоянии .....  $2 \cdot 10^4$  ч  
 Количество циклов перепрограммирования .....  $\geq 25$

### Режим работы ИС

Режим работы	$\overline{CS}$	$\overline{OE}$	$\overline{PGM}$	$U_p$	$U_n$	Входы - выходы
"Считывание"	$U^0_{вх}$	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	$U_p$	$U_n$	Выходная информация
"Невыбор ИС"	$U^1_{вх}$	-	-	$U_p$	$U_n$	Высокий импеданс
"Программирование"	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	Импульс $\overline{PGM}$	$U_p$	$U_n$	Входная информация
"Запрет программирования"	$U^1_{вх}$	-	-	$U_p$	$U_n$	Высокий импеданс
"Проверка программирования"	$U^0_{вх}$	$U^0_{вх}$	$U^1_{вх}$	$U_p$	$U_n$	Выходная информация

## Предельно допустимые режимы эксплуатации

Максимальное напряжение питания .....	5,25 В
Минимальное входное напряжение высокого уровня .....	2,4 В
Максимальное напряжение на выводе 1 .....	5,25 В
Выходной ток высокого уровня .....	-180...0 мкА
Выходной ток низкого уровня .....	0...1,8 мА
Максимальная емкость нагрузки .....	100 пФ
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °С